

3.6. НОВИ ТИПОВЕ ТИРИСТОРИ (СКС, ЧССР)

$$\frac{T}{a} \frac{R}{b} \frac{967}{c} \frac{\square}{z} - \frac{400}{d} - \frac{08}{e} - \frac{K}{ж} - \frac{H}{з} \frac{K}{и} \frac{F}{к}$$

- a** — Тиристор
б — Тиристорна характеристика.
 Без буква=стандартен тип;
R =с повишено бързодействие;
V =за високо напрежение;
в — Конструктивно изпълнение
г — Конструктивни подробности
 Без маркировка=обикновено изпълнение
С маркировка=тиристор с плоска квадратична основа
д — Максимално допустим ток при непрекъснатата работа, А
е — Клас по напрежение. Числото, умножено със 100, дава максимално допустимото обратно напрежение и максималното положително напрежение при запушено състояние
ж — Група по напрежение върху тиристора в отпушено състояние
К — означените с тази буква тиристори могат да се включват паралелно. Ако тази буква липсва, паралелно свързване е невъзможно.
з — Група по du/dt
 E= 100 V/ μ s
 H= 200 V/ μ s
 N=1000 V/ μ s
 R=2500 V/ μ s
и — Група по di/dt
 D= 50 A/ μ s
 H=100 A/ μ s
 K=200 A/ μ s
к — Група по време на изключване
 O=без гаранция, E=15 μ s,
 F=20 μ s, G=25 μ s, H=30 μ s,
 I=40 μ s, L=50 μ s.

3.7. ТИРИСТОРИ (АЕГ, ФРГ)

$$\frac{T}{a} \frac{100}{b} \frac{1}{c} \frac{800}{z} \frac{E}{d} \frac{D}{e} \frac{H}{ж}$$

- a* — Тиристор
- б* — Максимално допустим ток при непрекъсната работа, А
- в* — Конструктивни подробности: F=серия с гарантирани най-добри стойности за времето на изключване (предимно за схеми с по-голямо бързодействие); N=серия с добри възможности за запущване без гарантирана най-добра стойност за t_0 (предимно за схеми при честота 50 Hz).
- г* — Максимално допустимо положително и отрицателно напрежение на тиристора в запушено състояние, V
- д* — Механично изпълнение

Анод	Катод
A=проводник —	проводник
B=винтов щифт —	многожилен проводник
C=винтов щифт —	ухо за спояване
E=плоска основа —	многожилен проводник
H=пресован корпус —	ухо за спояване
S=таблетъчен тиристор	

е — Група по време на изключване

$B \leq 10 \mu s$	$C \leq 12 \mu s$	$D \leq 15 \mu s$,
$E \leq 20 \mu s$,	$F \leq 25 \mu s$,	$G \leq 30 \mu s$,
$K \leq 40 \mu s$,	$M \leq 50 \mu s$	

O=няма гаранция за най-добра стойност

ж — Група по du/dt

A=20 V/ μs при нарастване до 67% U_{DRM}
B=50 V/ μs при нарастване до 67% U_{DRM}
C=400 V/ μs при нарастване до 67% U_{DRM}
E=200 V/ μs при нарастване до 67% U_{DRM}
F=1000 V/ μs при нарастване до 67% U_{DRM}
H=400 V/ μs при нарастване до 45% U_{DRM}

3.8. ТИРИСТОРИ (ВВС, ФРГ)

CS	□	34	—	08	g	o	3	2
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>		<i>г</i>	<i>д</i>	<i>е</i>	<i>ж</i>	<i>з</i>

- a* — Тиристор (на силициева подложка)
- б* — Конструктивни подробности
 - F=бързодействащ тип (високофrequentен тиристор)
 - R=тиристор, провеждащ в обратна посока
- в* — Мощност на тиристора (характерна стойност на тока, А)
- г* — Клас по напрежение. Числото, умножено със 100, дава максимално допустимото обратно напрежение и максималното положително напрежение при запушено състояние